Преобразователь постоянного напряжения понижающий 1326ПН1Т, 1326ПН1Т1

Микросхема 1326ПН1Т - понижающий преобразователь напряжения с фиксированным выходным напряжением 5.0 В и током нагрузки до 1.0A.

Микросхема предназначена для использования в источниках питания аппаратуры, устойчивой к воздействию СВВФ.

Микросхема 1326ПН1Т изготавливается в металлокерамическом 8 - выводном корпусе 4116.8-3, микросхема 1326ПН1Т1 – в металлокерамическом корпусе 4112.8-1.01.

Функциональный аналог – микросхема AP1501-5.0 компании Anachip.

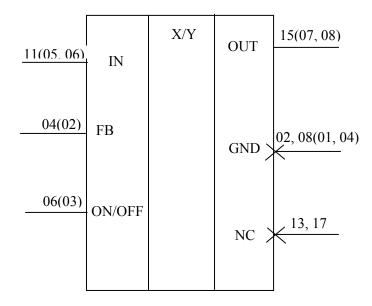
Основные характеристики:

- генератор со встроенной емкостью на частоту 150кГц;
- схема ШИМ управления выходным напряжением;
- защита от превышения температуры кристалла;
- защита от превышения выходного тока;
- вход управления включением/выключением;
- входное напряжение микросхемы должно быть в диапазоне от 10В до 35В;
- низкое энергопотребление в режиме ожидания;
- фиксированное значение выходного напряжения 5.0B± 4 %.

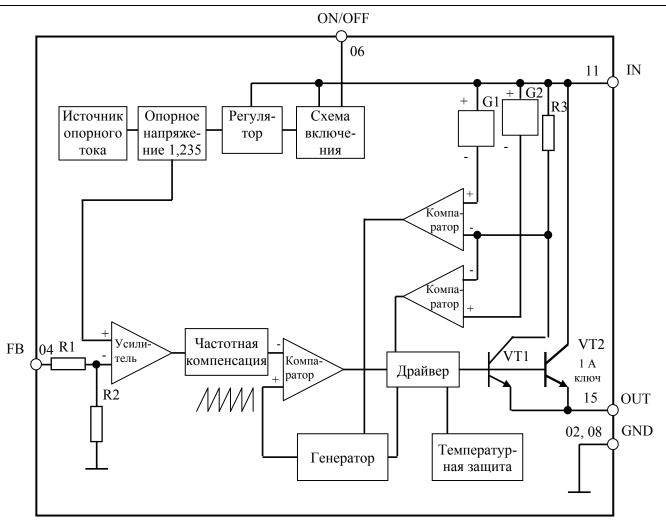
Назначение выводов микросхемы

Номер вывода микросхемы 1326ПН1Т	Номер вывода микросхемы 1326ПН1Т1	Обозначение	Назначение
02	01	GND	Общий вывод
04	02	FB	Вход обратной связи
06	03	ON/OFF	Вход включения/выключения
08	04	GND	Общий вывод
11	05, 06	IN	Вход
13	-	NC	Вывод свободный
15	07, 08	OUT	Выход
17	-	NC	Вывод свободный

Условное графическое обозначение



Примечание. В скобках указаны номера выводов микросхемы 1326ПН1Т1.



G1 – источник постоянного напряжения 200 мВ;

G2 – источник постоянного напряжения 220 мВ;

R1 – R3 – резисторы;

VT1, VT2 – транзисторы

Схема электрическая структурная

Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Have constant and the c	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
Наименование параметра режима, единица измерения		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Входное напряжение, В	$U_{\scriptscriptstyle BX}$	10	35	10	45
Напряжение на выходе, без подключения LC-фильтра, В	$U_{\text{вых 1}}$	-0,8		-1,0	_
Входное напряжение низкого уровня на входе ON/OFF (Вкл.), В	$\mathrm{U}^0_{_{_{\mathbf{BX}}}}$	0	0,4	-0,3	-
Входное напряжение высокого уровня на входе ON/OFF (Выкл.), В	$\mathrm{U}^{\mathrm{l}}_{_{_{\mathbf{BX}}}}$	2,2	5,0	ı	25
Напряжение на входе обратной связи, В	U_{OC}	0	12	-0,3	25
Выходной ток, А	$I_{\scriptscriptstyle m BMX}$	-0,2	-1,0	_	-1,25
Рассеиваемая мощность, Вт:1)	P_{pac}				
- для микросхемы 1326ПН1Т		_	1,25	_	1,56
- для микросхемы 1326ПН1Т1		_	0,625	_	0,78

Примечание - Одновременное воздействие нескольких предельных режимов не допускается.

Мощность, рассеиваемую микросхемой $P_{\text{pac.}}$, Вт, при температуре среды T_{OKP} от минус 60 до плюс 125 °C определяют по формуле

$$P_{pac} = (150 - T_{OKP}) / R_{T KP-OKP} , \qquad (1)$$

где 150 – температура кристалла, °С;

 T_{OKP} – температура среды, °C;

 $R_{T\,KP\text{-}OKP}$ — тепловое сопротивление кристалл - среда, не более 80 °C/Вт для микросхемы 1326ПН1Т, не более 160 °C/Вт для микросхемы 1326ПН1Т1

¹⁾ При температуре среды $T_{OKP} = 25$ °C.

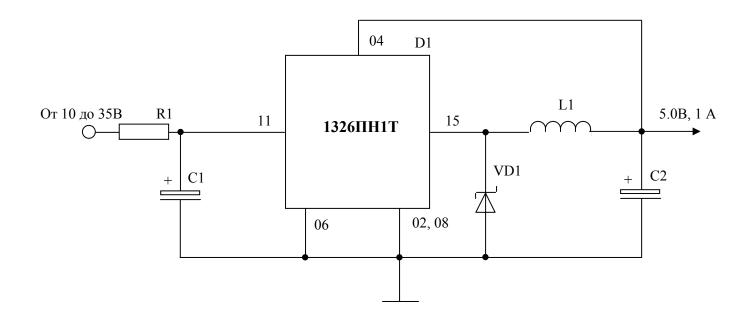
Электрические параметры микросхем

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма параметра		Темпера- тура сре-
The state of the s	параметра	не менее	не более	ды, °С
Выходное напряжение, В,	$U_{\scriptscriptstyle m BMX}$	4.8	5.2	25 ± 10
$10B \le U_{BX} \le 35B$; $-0.2A \le I_{Bbix} \le -1.0A$		4.5	5.5	- 60; 125
Остаточное напряжение, В,	U _{нас}	_	1.5	25 ± 10
$I_{\text{вых}} = -1.0 \text{A}$, нет внешней цепи, $U_{\text{OC}} = 0$, $U_{\text{вх}} = 27 \text{B}$		_	2.0	- 60; 125
Ток утечки на выходе, мА	ī	_	-0.5	25 ± 10
$U_{\text{вх}} = 35 \text{B}, U_{\text{вых}} = 0, \text{нет внешней цепи}, U_{\text{OC}} = 12 \text{B}$	$I_{y_{T,Bbix}}$	_	-1.0	- 60; 125
Ток потребления, мА,	_	_	20	25 ± 10
$U_{OC} = 12B, U_{BX} = 27B$	I_{not}			
		_	30	- 60; 125
Максимальный выходной ток, А,	$I_{\scriptscriptstyle Bbix.\ max}$	-1.5	-5.5	25 ± 10
пиковый ток, нет внешней цепи, $U_{OC} = 0$, $U_{BX} = 12B$	вых. тах			- 60; 125
Ток потребления в ждущем режиме, мкА,	$I_{\text{пот. жд}}$	_	400	25 ± 10
$U_{BX}^{1} = 5.0B, U_{BX} = 35B$		_	500	- 60; 125
Входной ток высокого уровня по входу ON/OFF (Выкл.), мкА,	I_{BX}^1		50	25 ± 10
$U_{BX}^{1} = 2.5B, U_{BX} = 27B$			75	- 60; 125
Входной ток низкого уровня по входу ON/OFF (Вкл.), мкА,	I_{BX}^0		± 20	25 ± 10
$U_{BX}^0 = 0.5B, U_{BX} = 27B$		_	± 30	- 60; 125
Частота генератора, кГц	$f_{\scriptscriptstyle \Gamma \rm CH}$	110	180	25 ± 10
$U_{BX} = 27 \text{ B}, I_{BMX} = -0.5 \text{ A}$	1ген	75	300	- 60; 125

Примечание.

Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток).

За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока



С1, С2 – конденсаторы электролитические емкостью 470мкФ

D1 – микросхема

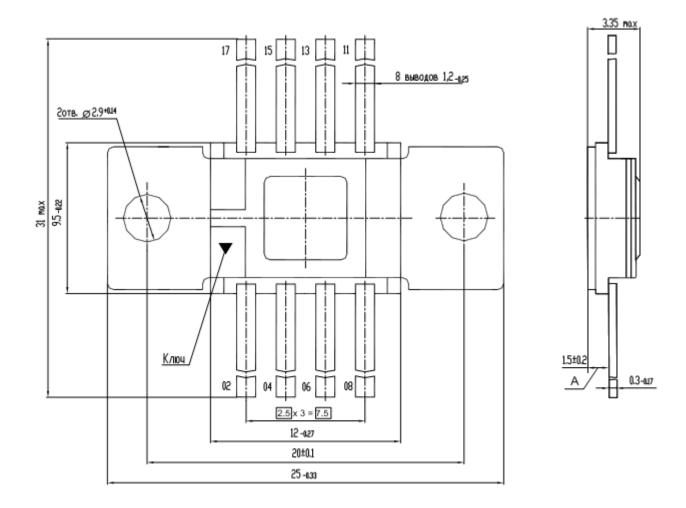
L1 – катушка индуктивности 68мкГн

R1 – токоограничительный резистор

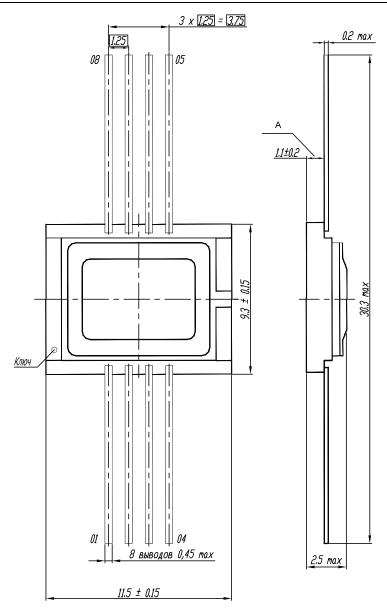
VD1 – диод Шотки (выбирается с учетом следующих особенностей: обратное напряжение диода должно быть больше максимального входного напряжения – 35B, ток через диод в прямом включении должен быть больше, чем ток ограничения)

Примечание. Время нахождения микросхемы в режиме короткого замыкания не более 100мс.

Типовая схема включения микросхемы 1326ПН1Т



Габаритный чертеж корпуса 4116.8-3



Габаритный чертеж корпуса 4112.8-1.01